

・招待講演

※国際会議招待講演

1. N. Kobayashi, T. Akasaka, S. Ando, and M. Kumagai, "Growth shape control of group-III nitrides by selective area MOVPE", An Asia Pacific Symposium on Optoelectronics, Taiwan (1998).
2. N. Kobayashi, S. Ando, T. Nishida, Y. Kobayashi, and T. Akasaka, "Surface Stoichiometry and evolution of crystal facet during selective area MOVPE", 1998 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM1998), Hiroshima, Japan (1998).
3. N. Kobayashi, T. Nishida, T. Akasaka, S. Ando, and H. Saito, "AlGaIn UV-LEDs with high efficiency and InGaIn LDs using grown facet mirrors", 4th International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes (ISBLLED-4), Cordoba, Spain (2002).
4. Y. Kobayashi and T. Akasaka, "Boron Nitride grown by MOVPE", 14th International Conference on Metalorganic vapor phase epitaxy (ICMOVPE-XIV), Metz, France (2008).
5. Y. Kobayashi, C. L. Tsai, and T. Akasaka, "Optical band gap of hexagonal BN epitaxial film grown on c-plane sapphire substrate", 2009 Asian Core Workshop on Wide Bandgap Semiconductor, Gyeongju, Korea (2009).
6. T. Akasaka, Y. Kobayashi, and M. Kasu, "Step-free GaN hexagons grown by selective-area metalorganic vapor phase epitaxy", 3rd International Symposium on Growth of III-nitrides (ISGN-3), Montpellier, France (2010).
7. T. Akasaka, H. Gotoh, Y. Kobayashi, and H. Yamamoto, "Extremely narrow violet photoluminescence line from ultrathin InN single quantum well on step-free GaN surface", International Workshop on Nitride Semiconductors 2012 (IWN2012), Sapporo, Japan (2012).
8. Y. Kobayashi, K. Kumakura, T. Akasaka, H. Yamamoto, and T. Makimoto, "Layered boron nitride as a release layer for mechanical transfer of GaN-based devices", International Workshop on Nitride Semiconductors 2012 (IWN2012), Sapporo, Japan (2012).
9. T. Akasaka, Y. Kobayashi, C.-H. Lin, and H. Yamamoto, "Study of nucleus and spiral growth mechanisms of GaN using selective-area MOVPE on GaN bulk substrate", Intensive Discussion on Growth of Nitride Semiconductors, Sendai, Japan (2012).
10. Y. Kobayashi, K. Kumakura, T. Akasaka, H. Yamamoto, and T. Makimoto, "Layered Boron Nitride as a Release Layer for Mechanical Transfer of GaN-based Devices", The 4th International Symposium on Organic and Inorganic Electronic Materials and Related Nanotechnologies, Kanazawa, Japan (2013).
11. K. Kumakura, Y. Kobayashi, M. Hiroki, T. Makimoto, T. Akasaka, and H. Yamamoto, "Mechanically Transferred GaN-based Optical and Electronic Devices - A method for Lifting Thin-Film Devices from Substrates using Hexagonal BN -", International Semiconductor Device Research Symposium 2013, WP2-02, Maryland, USA (2013).
12. Y. Kobayashi, K. Kumakura, T. Akasaka, H. Yamamoto, and T. Makimoto, "Application of BN for GaN devices", 2014 Photonic West, 8986-12, San Francisco, USA (2014).
13. Y. Kobayashi, K. Kumakura, T. Akasaka, H. Yamamoto, and T. Makimoto, "Layered boron nitride as a release layer for mechanical transfer of GaN-based devices", 2014 IEEE Silicon Nanoelectronics Workshop, Honolulu, USA (2014.6).
14. M. Hiroki, K. Kumakura, Y. Kobayashi, T. Akasaka, H. Yamamoto, and T. Makimoto, "GaN on h-BN technology for release and transfer of nitride devices", 2014 4th IEEE International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration. Tokyo, Japan (2014.7).

15. M. Hiroki, K. Kumakura, Y. Kobayashi, T. Akasaka, T. Makimoto, and H. Yamamoto, “Epitaxial lift off of GaN heterostructure by BN insertion”, 2nd Intensive Discussion on Growth of Nitride Semiconductors, Sendai, Japan (2014.10).

※国内会議招待講演

1. 赤坂哲也, 安藤精後, 小林康之, 熊谷雅美, 小林直樹, “窒化物半導体の選択成長とフェーズトレースへの応用”, 応用電子物性分科会研究例会, 東京, (1998).
2. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “表面過飽和度制御による GaN ステップフリー面の形成”, 第3回 窒化物半導体結晶成長講演会, 九州大学 筑紫キャンパス(2011), IN3.
3. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “層状窒化ホウ素を用いた GaN 系デバイスの剥離転写技術”, プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会第 120 回研究会, 10 月 26 日, プラザエフ, 四谷, 東京 (2012.10).
4. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “層状窒化ホウ素を剥離層とする GaN 系デバイスの機械的転写法の開発”, 日本学術振興会 ワイドギャップ半導体光・電子デバイス 162 委員会 半導体界面制御技術第 154 委員会, 3 月 1 日, プラザエフ, 四谷, 東京 (2013.3).
5. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “層状窒化ホウ素を剥離層とする GaN 系デバイスの機械的転写法の開発”, 電気学会電子デバイス研究会, 3 月 7 日～8 日, アピカルイン京都, 京都 (2013.3).
6. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “層状窒化ホウ素を剥離層とする GaN 系デバイスの機械的転写法の開発”, 応用電子物性分科会研究例会, 2013 年 6 月 7 日, 京都 (2013.6).
7. 廣木正伸, 熊倉一英, 小林康之, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “極薄層状 BN 剥離層を用いた GaN 系デバイスの転写技術”, 低温接合による 3D 集積化研究会, 東京(2014.5).
8. 赤坂哲也, “GaN の MOVPE 成長と表面過飽和度”, 第 8 回 窒化物半導体結晶成長講演会, 京都大学 桂キャンパス(2016.5), T-Tu-1. [チュートリアル講演]